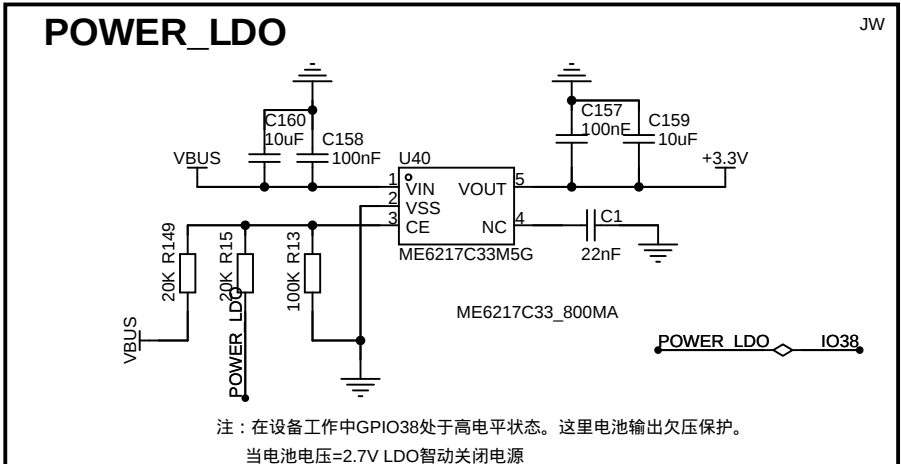
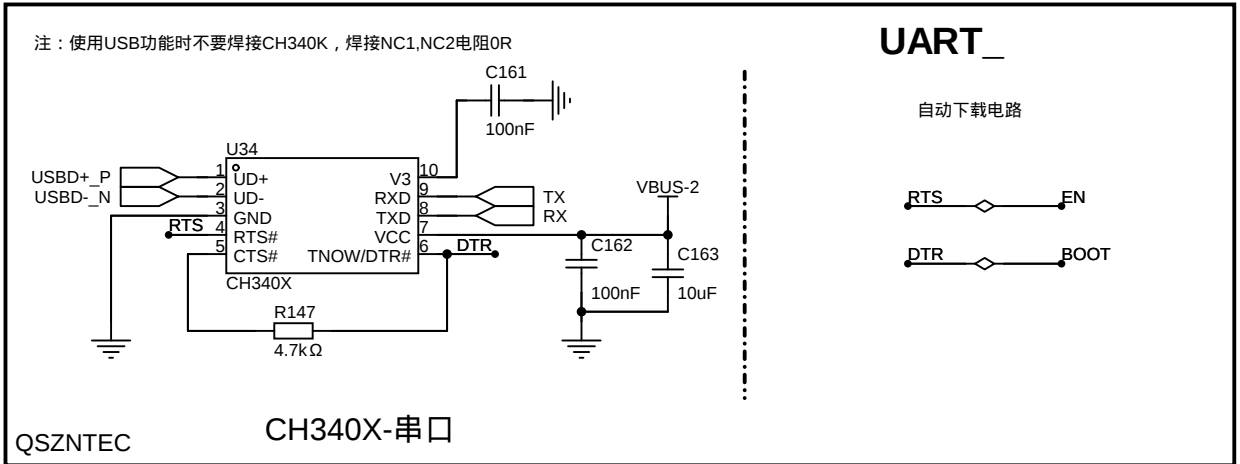
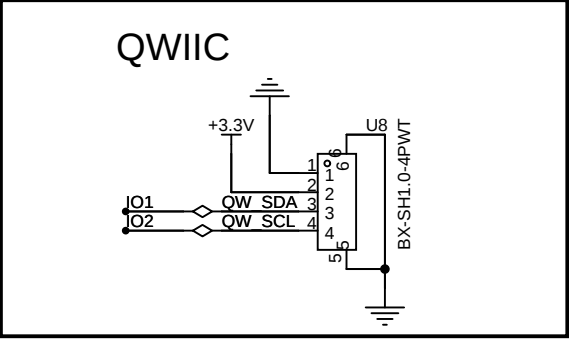
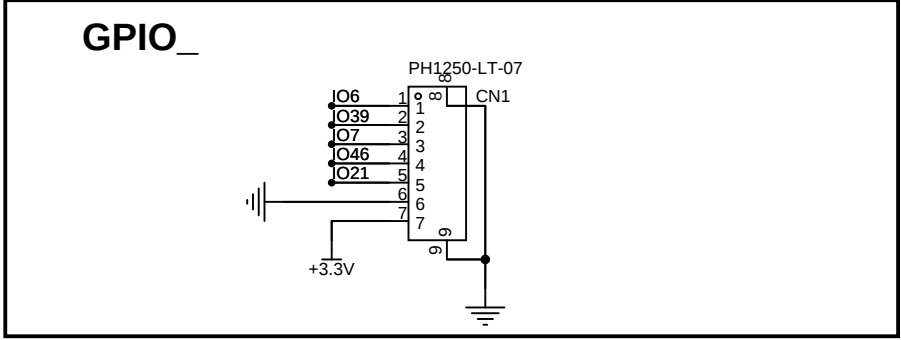
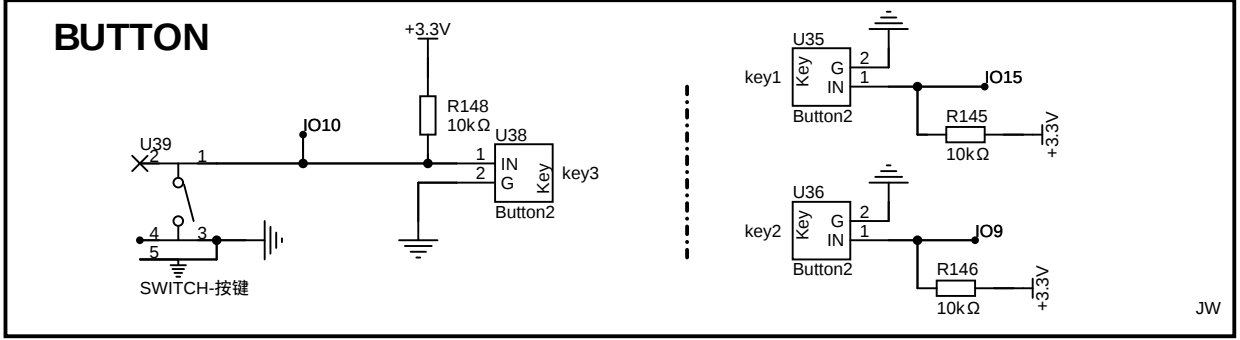
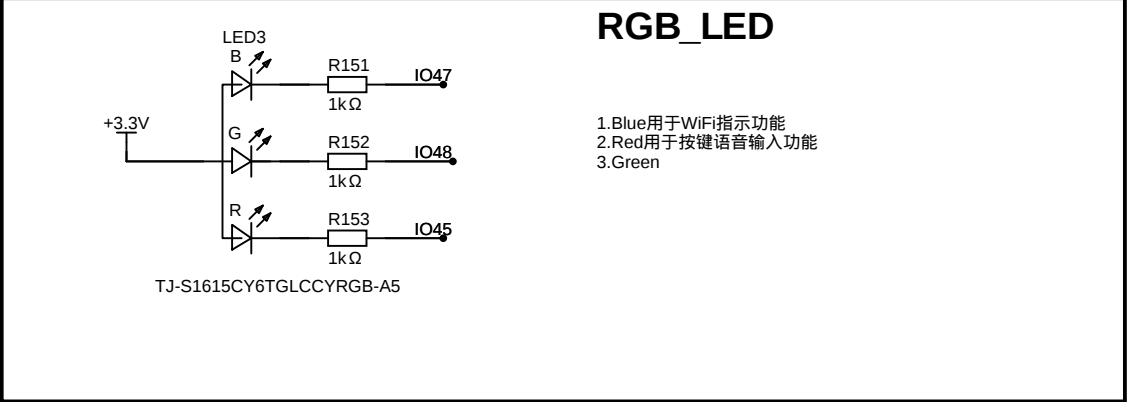
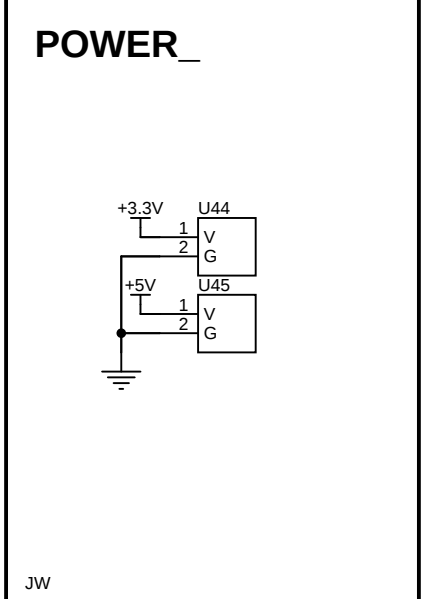
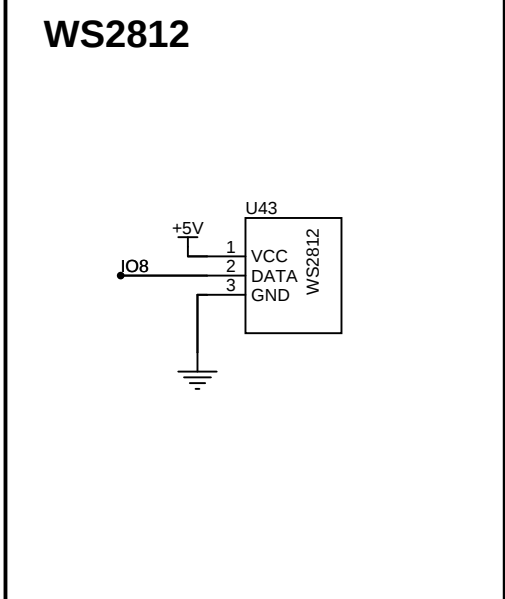
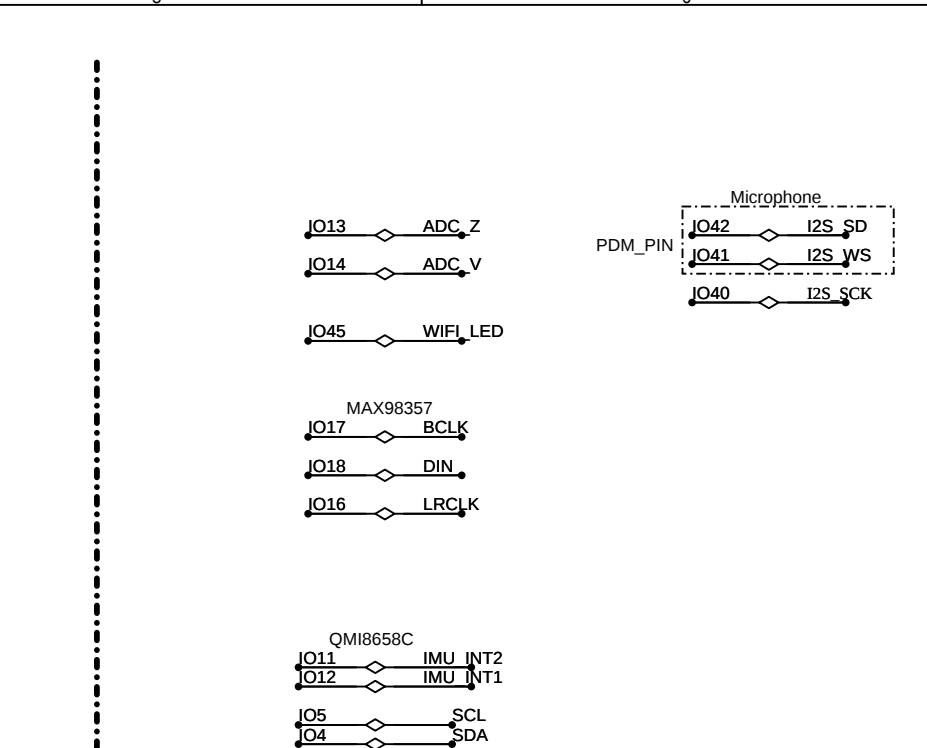
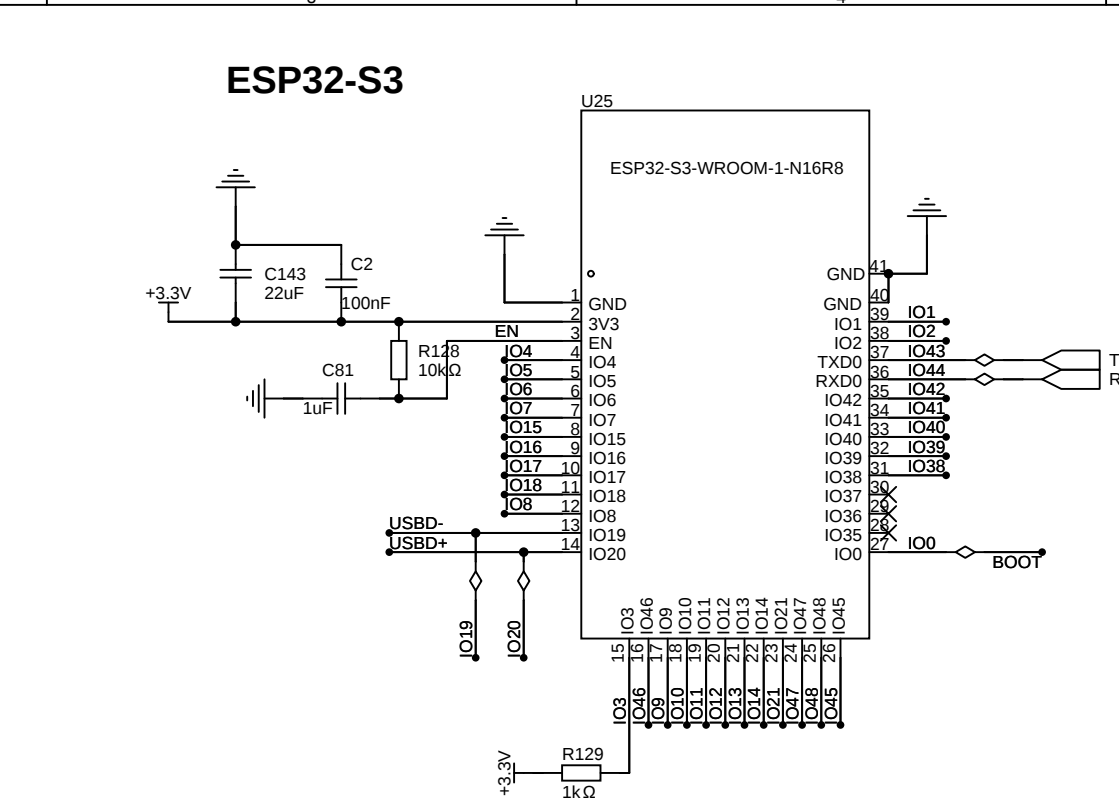
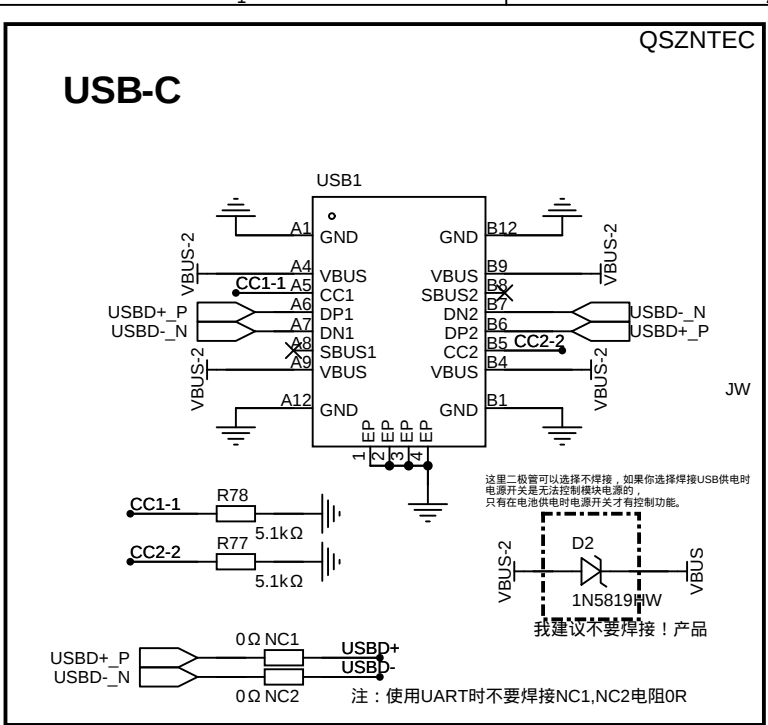
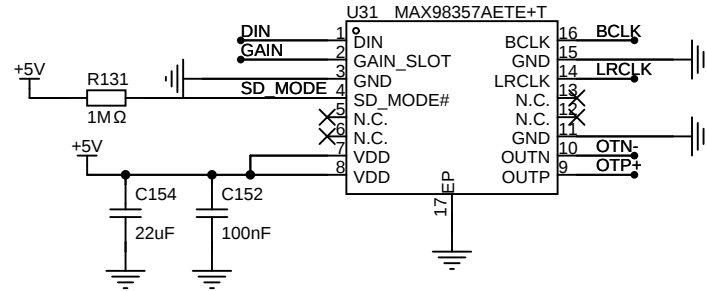
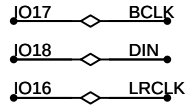




MAX98357A_

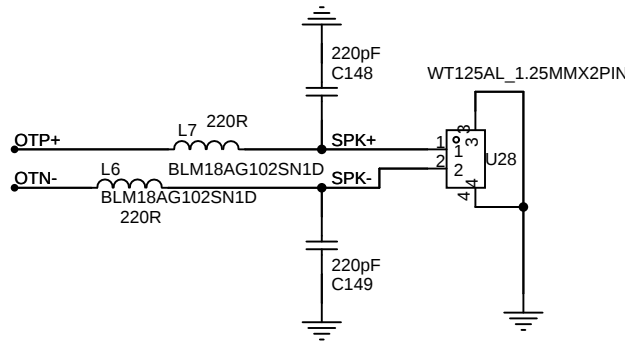
3.2W Output Power into 4 Ω at 5V



*当GPIO(SD_MODE)较高时，响应左通道。当GPIO较低时，最大值98357a/b被关闭。
关闭和通道选择。低拉SD_MODE，使设备关闭。
在I2S或LJ模式下，SD_MODE选择数据通道。
在TDM模式下，SD_MODE和GAIN_SLOT均用于通道选择。 QSZNTEC

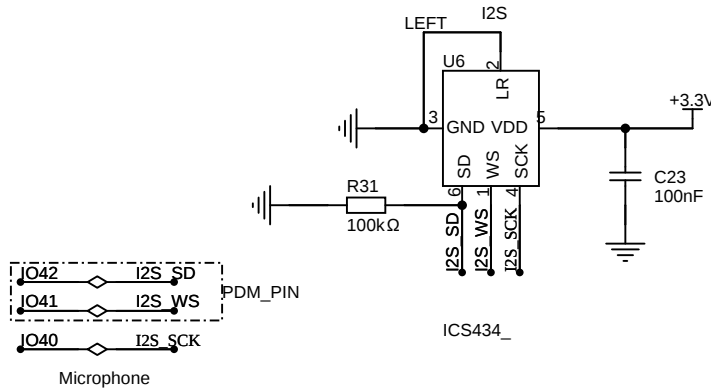
GAIN_SLOT:增益和通道选择。在I2S和LJ模式下，确定了放大器的输出增益。
在TDM模式下，用于与SD_MODE的信道选择。在TDM模式下，增益固定在12 dB。

LRCLK:帧时钟。I2S和LJ模式的左右时钟。实现TDM模式下的同步时钟。

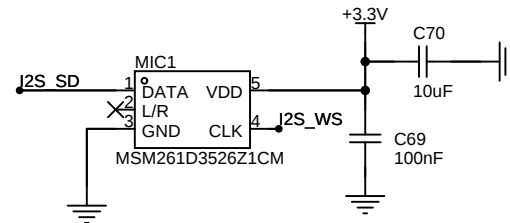


JW

Microphone



PDM
DATA= 32
CLK = 15



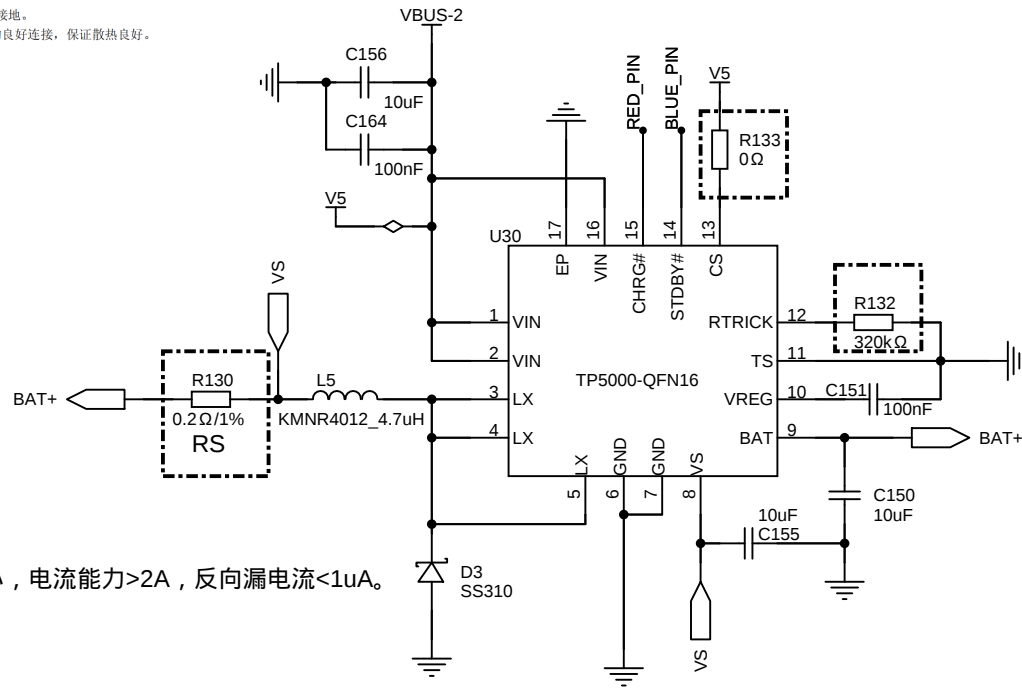
1. 电路中电容都应尽量靠近芯片。
2. VS端VIN端与BAT端使用钽电容、X5R或X7R级陶瓷电容或电解电容加0.1uF陶瓷电容。
3. 电感请选用电流能力足够的功率电感。
4. 肖特基二极管选用导通压降小电流能力大于等于2A的肖特基二极管。
5. 对于VIN及LX通过电流回路的走线应比普通信号线更宽。
6. 注意各电容接地线节点位置，应尽量使接地点集中，良好接地。
7. 使用芯片在大电流工作中，应考虑芯片底部散热片与PCB的良好连接，保证散热良好。

表 2: Rs 及其对应的恒流充电电流

Rs (Ω)	I _{BAT} (mA)
1	100
0.2	500
0.1	1000
0.067	1500
0.05	2000

肖特基二极管选择：导通压降小，电流能力>2A，反向漏电流<1uA。

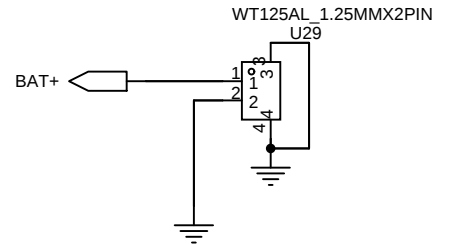
INMaxV:5V-9V



- 1.电阻R133：(1).锂离子电池充电时焊接0R电阻。
(2).磷酸铁锂电池充电时不焊接R133电阻。
- 2.电阻R132：(1).给锂电池充电时焊接320k电阻。
(2).给磷酸铁锂电池时焊接0R电阻。
(3)涓流预充电流设置端
- 3.TS为电池温度保护引脚，这里无温度保护

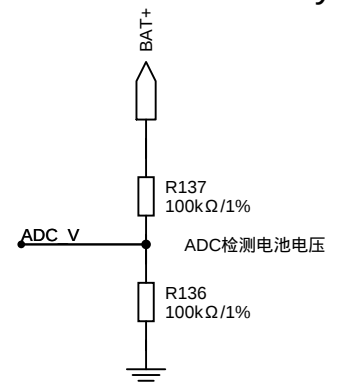
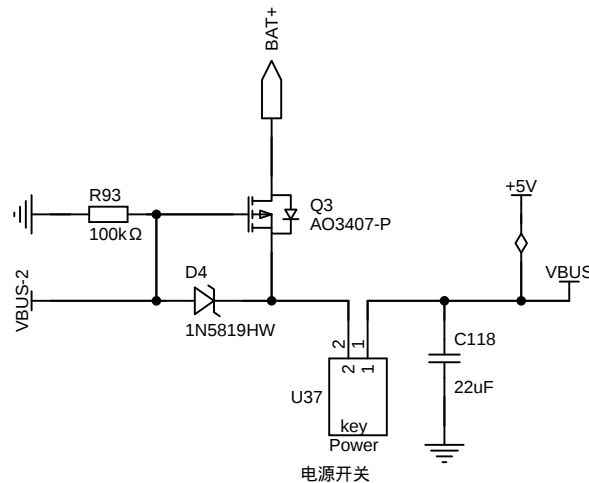
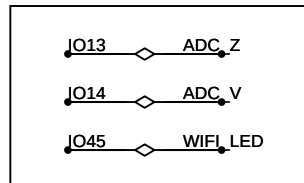
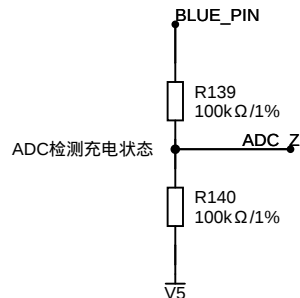
表 3: R_{TRICK} 及其设定的涓流电流与恒流电流 I_{BAT} 的关系:

R _{TRICK} (k)	I _{TRICK} (mA)
0	10% I _{BAT}
50k	20% I _{BAT}
114k	30% I _{BAT}
320k	50% I _{BAT}
引脚悬空	100% I _{BAT}



Battery interface

- 1.当充电时 (BLUE_PIN) 处于高阻态，充满电低阻态



QMI8658C

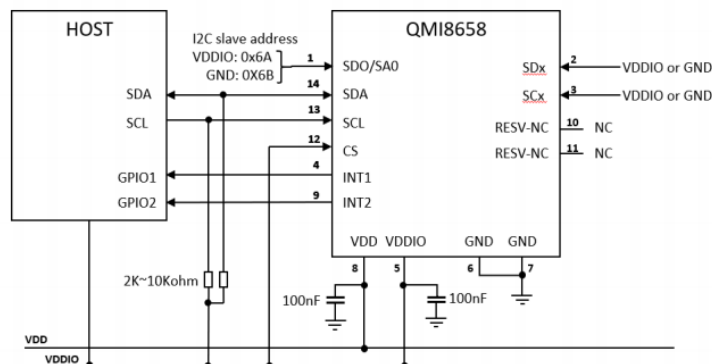
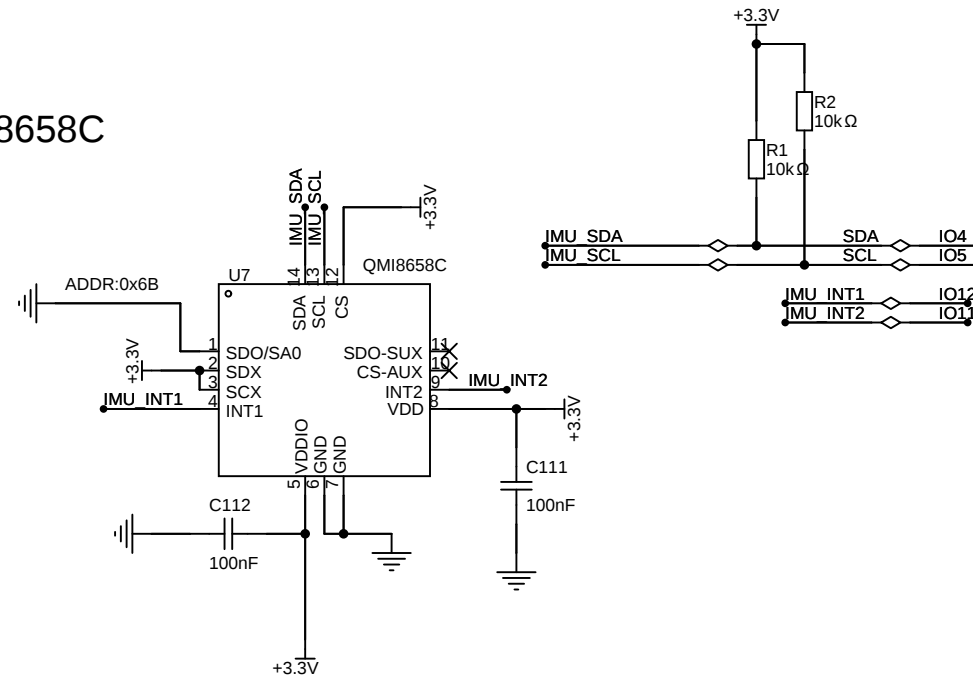


Figure 6. I3C/I²C-UI mode

Note: As there is internal 200Kohm pull-up resistor, pull SDO/SA0 low will cost more current then pull it high.

UpDate:2024/12/27